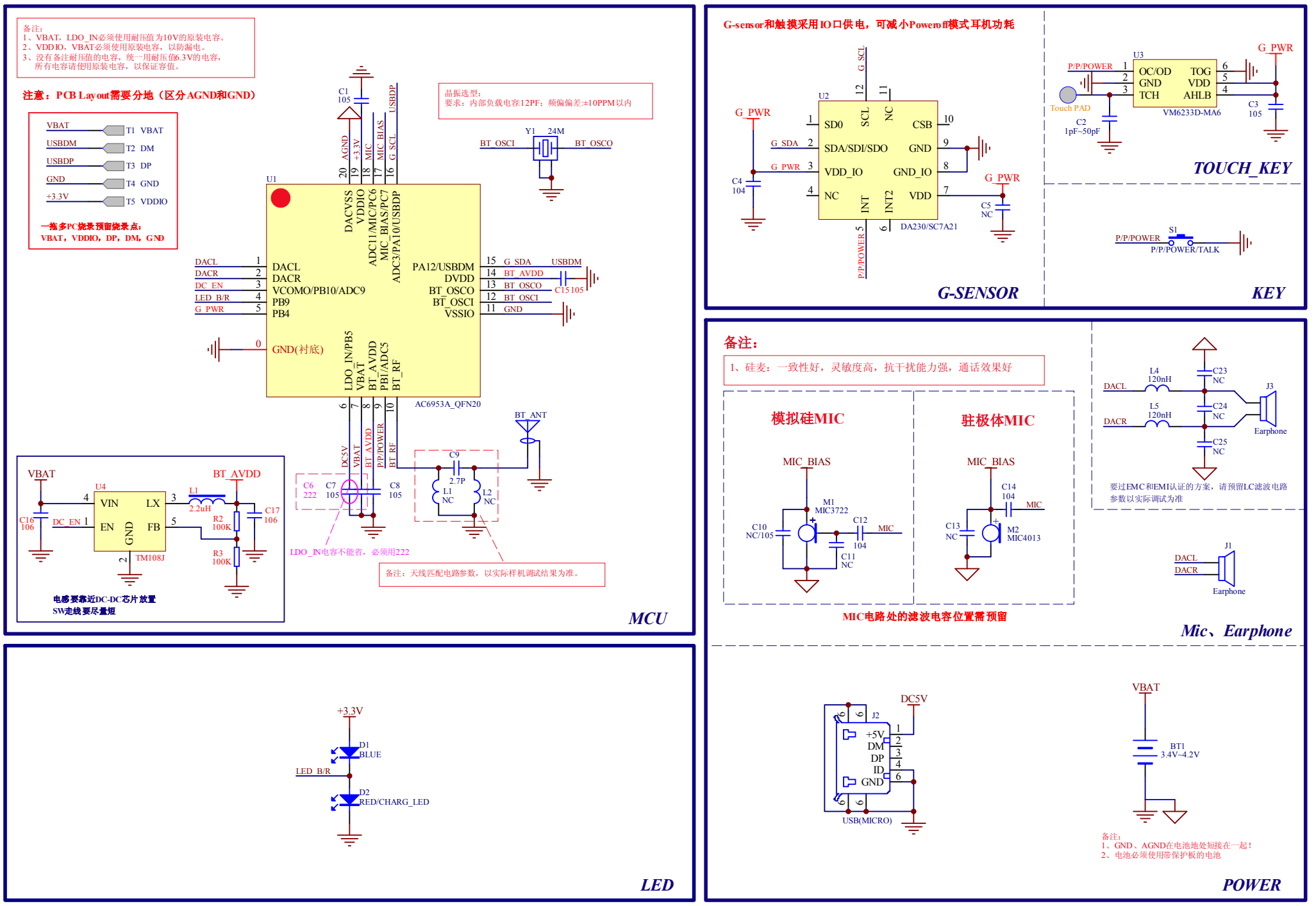

备注：
1、VBAT，LDO_IN必须使用耐压值为10V的原装电容。
2、VDDIO，VBAT必须使用原装电容，以防漏电。
3、没有备注耐压值的电容，统一用耐压值6.3V的电容，
所有电容请使用原装电容，以保证容值。
注意：PCB Layout需要分地（区分AGND和GND）
VBAT T1 VBAT
USBDM T2 DM
USBDP T3 DP
GND T4 GND
+3.3V T5 VDDIO
一拖多PC烧录预留烧录点：
VBAT，VDDIO，DP，DM，GND
晶振选型：
要求：内部负载电容12PF；频偏偏差:±10PPM以内
U1
AC6953A_QFN20
DACL
DACR
VCOMO/PB10/ADC9
PB9
PB4
GND(衬底)
DACVSS
VDDIO
ADC11/MIC/PC6
MIC_BIAS/PC7
ADC3/PA10/USBDP
PA12/USBDM
DVDD
BT_OSCO
BT_OSCI
VSSIO
LDO_IN/PB5
VBAT
BT_AVDD
PB1/ADC5
BT_RF
Y1 24M
BT_OSCI
BT_OSCO
BT_ANT
C1 105
C15 105
C6 222
C7 105
C8 105
C9 2.7P
L1 NC
L2 NC
LDO_IN电容不能省，必须用222
备注：天线匹配电路参数，以实际样机调试结果为准。
U4
VIN
LX
EN
GND
FB
TM108J
L1 2.2uH
C16 106
C17 106
R2 100K
R3 100K
电感要靠近DC-DC芯片放置
SW走线要尽量短
MCU
+3.3V
D1 BLUE
LED_B/R
D2 RED/CHARG_LED
LED
G-sensor和触摸采用IO口供电，可减小Poweroff模式耳机功耗
U2
SD0
SDA/SDI/SDO
VDD_IO
NC
SCL
INT
CSB
GND
GND_IO
VDD
INT2
DA230/SC7A21
G_PWR
G_SDA
G_SCL
P/P/POWER
C4 104
C5 NC
G-SENSOR
U3
P/P/POWER
OC/OD
GND
TCH
TOG
VDD
AHLB
VM6233D-MA6
Touch PAD
C2 1pF~50pF
C3 105
TOUCH_KEY
S1
P/P/POWER/TALK
KEY
备注：
1、硅麦：一致性好，灵敏度高，抗干扰能力强，通话效果好
模拟硅MIC
MIC_BIAS
M1 MIC3722
C10 NC/105
C11 NC
C12 104
MIC
驻极体MIC
C13 NC
C14 104
M2 MIC4013
MIC电路处的滤波电容位置需预留
L4 120nH
L5 120nH
C23 NC
C24 NC
C25 NC
J3
Earphone
DACL
DACR
要过EMC和EMI认证的方案，请预留LC滤波电路参数以实际调试为准
J1
Earphone
Mic、Earphone
DC5V
J2
+5V
DM
DP
ID
GND
USB(MICRO)
VBAT
BT1 3.4V~4.2V
备注：
1、GND、AGND在电池地处短接在一起！
2、电池必须使用带保护板的电池
POWER